آزمایشگاه فیزیک پیشرفته

میکروسکوپ تونلی Scanning Tunneling Microscopy (STM)

مقدمه

این میکروسکوپ از مهمترین میکروسکوپهای ساخته شده برای مشاهده مستقیم ساختار و خواص الکتریکی سطح در ابعاد اتمی است. اصول کار آن بر اساس اعمال پتانسیل کم بین سوزن با ابعاد زیر میکرونی و سطح جسم و ثبت جریان تونلی بین این دو می باشد. شکل 1 شماتیک ساختار یک میکروسکوپ را نشان می دهد. سوزن از جنس فلزات سخت مثل 1 و 1 است که به سه نقطه پیزوالکتریک مثل PbZrTio3 با ثابت 1 شابت 1 و 1 ساختار یک میکروسکوپ را نشان می دهد.

احتمال تونلزنی بستگی به همپوشانی اربیتالهای الکترونی سطح سوزن وماده مورد نظر دارد و جریان کل در بایاس برابر است با:

$$I = \frac{e}{\hbar} \sum_{1,2} |M_{12}|^2 \delta(E_1 - E_2) [f(E_1) - f(E_2 + eV)]$$

تابع f تابع فرمی دیراک، E و E انرژی حالات اتمی و M_{12} ماتریس انتقال از حالت E و E است. در ولتاژ بایاس کم دانسیته این جریان برابر است با:

$$J = \frac{e^2}{\hbar} \frac{K.}{4n^2 d} V \exp(-2K.d)$$

که 2K.(nm)=0/1025E و $arepsilon=rac{E_1+E_2}{2}$ و arepsilon=1 فاصله است. تغییر فاصله 1 باعث تغییر در جریان قابل اندازه گیری می شـود. قدرت

تفکیک عمودی 0/1 و کمتر است و افقی بستگی به ناصافی سطح و شعاع سوزن دارد. اهمیت ثابت بودن مجموعه منجر به ساخت مجموعه غیرارتعا شی بعنوان نگهدارنده شده است. این میکرو سکوپ معمولاً در خلاء (p<10-9Tott) UHV بکار می رود تا سطح تمیز مورد مطالعه قرار گیرد ولی می توان در هوا و یا آب (مایعات) هم بکار برد. از کاربردهای دیگر این میکرو سکوپ ک سب اطلاعات ا سپکترو سکوپی در محل مشخص از اتمها است. با ثبت منحنی I(V) و تغییر ولتاژ، V می توان اطلاعات مفیدی از ساختار نواری بدست آورد. سه مود اصلی در این میکروسکوپ وجود دارد.

Zمود Z و V ثابت، مکان سوزن در صفحه تغییر می کند در این حالت جریان V اندازه گیری می شود.

. مود I و V ثابت و y,x متغیر را در این حالت اندازه می گیریم.

3- مود V متغير در اين حالت بقيه پارامترها را ما انتخاب مي كنيم و اندازه مي گيريم.

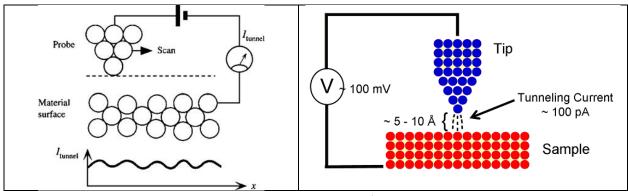
در مورد اول باید سطح تقریباً هموار باشد و در مورد دوم سوزن را در جهت Z حرکت میدهد تا جریان ثابت باشد. شکل Z شماتیک این مودها را نشان میدهد.

در مود سوم چندین بار I(V) اندازه گیری می شود. مشتق جریان به ولتاژ به کل نسبت جریان به ولتاژ I(V) به دانسیته حالات الکترونی محلی (LDOS) سطح بستگی دارد.

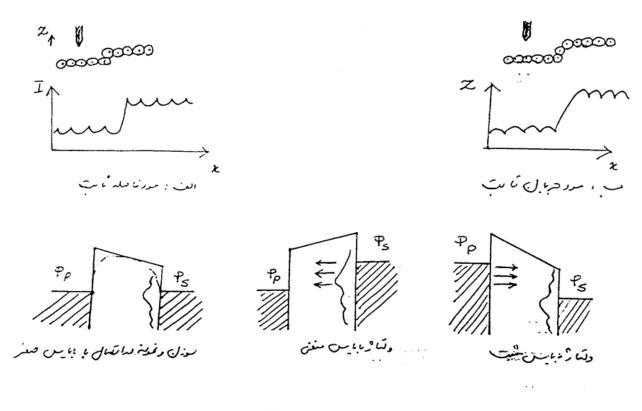
امروزه پیشرفت تکنولوژی در ساخت میکروسکوپ و استفاده از لیزر و الکترونیک پیشرفته تر باعث شده که بتوان انواع ذرات برهم کنشی دیگر بین سوزن و اتمهای سطح مثل فونونها و فوتونها هم آشکار شود بنابراین اطلاعات از خواص فیزیکی سطح بسیار و سیعتر گردیده است. البته عدم توانایی تونلزنی الکترونی از سطح مواد عایق این میکروسکوپ را از مطالعه سطوح مواد عایق عاجز کرده که در این مورد میکروسکوپ نیرو اتمی (AFM) Atomic Force Microscopy) بکار میرود.

معرفی دستگاه

دستگاه مورد آزمایش ساخت کارخانه Nanosurf AG است که بر روی پایه ضدارتعاشی بنا شده است قبل از آزمایش بدقت موارد احتیاط و جزوه راهنمایی د ستگاه خوانده و عمل شود و د ستگاه با نرمافزار easy scan رو شن و اندازه گیری می شود که نیاز است ابتدا با این نرمافزار آشنا شوید.



شکل 1: شماتیک عملکرد میکروسکوپ



شکل ۲: نمایش سه مود میکروسکوپ

احتياطهاي لازم

- 1- هرگز به سوزن و جایگاه آن دست نزنید و در موارد مورد لزوم از دستکش و در یک فضای عاری از گردوغبار کار کنید.
 - 2- برای بهتر دیدن وضعیت سوزن و سطح از ذره بین دستگاه استفاده کنید.
 - 3- تغییرات دمای محیط و یا لرزش باعث از بین رفتن وضوح تصویر میشود.
 - 4- قبل از شروع آزمایش حتماً دستورکار خوانده و با نرمافزار آشنا شوید.
 - 5- بیاحتیاطی منجر به شکستن سوزن و خراش نمونه میشود.

آشنایی با نرمافزار easy scan

همانطور که گفته شده این میکروسکوپ از مهمترین میکروسکوپهای ساخته شده برای مشاهده مستقیم ساختار و خواص الکتریکی سطح در ابعاد اتمی است. این مشاهده تو سط برنامه نرمافزاری easy scan انجام می گیرد. دستگاه مورد آزمایش بر روی پایه ضدارتعاشی بنا شده است.

مرحله اول آزمایش تنظیم سوزن میکرو سکوپ د ستگاه است. ابتدا تو سط ذرهبین این کار به طریقه د ستی انجام می دهیم تا جائیکه احساس کنیم دیگر با دقت نمی توانیم با ذره بین آنرا تنظیم کنیم. بعد تنظیم آنرا به نرم افزار (به طور اتوماتیک) واگذار می کنیم. بهتر اســـت قبل از روشن کردن STM دستگاه با نرم افزار آن آشنا شوید. برای اینکار کامپیوتر را روشن کنید. بعد از بالا آمدن برنامه ویندوز، پوشه مطور که به طور که بر روی این پو شه آنرا باز کنید. چند پنجره که به طور مناسبی کنار هم قرار گرفته اند روی طاهر می شود که هر کدام حاوی آیکونهای متفاوتی هستند. در پنجره گوشه سمت راست دو آیکون ↑ و با قرار دارد که آیکون ↑ برای دورکردن سوزن از سطح بلور مورد مطالعه، به طور دسـتی میباشـد، دور کردن دسـتی با کلیک کردن های متعدد بر روی آن انجام می گیرد و آیکون با برای نزدیک کردن سوزن با همان خصوصیات آیکون ↑ میباشد.

برای تنظیم اتوماتیک، بر روی آیکونی بنام Approach در همان پنجره کلیک میکنیم و نرمافزار با این دستور به طور خودکار سوزن را تنظیم میکند و پس از تنظیم پیغام میدهد که عملیات انجام شده است. نکته قابل ذکر این است که بر روی میکروسکوپ یک چراغ کوچک قرار دارد که سه رنگ را به نشانه علائم مختلف ارسال میدارد؛ 1- قرمز 2- نارنجی 3- سبز

رنگ قرمز: نشانه علامت خطر و احتمال آسیبدیدگی سوزن را اعلام میدارد که در این حالت سریعاً توسط [†] آیکون سوزن را دور میکنیم و دوباره عملیات تنظیم سوزن را انجام میدهیم.

رنگ نارنجی: نشانه وضعیت متعادل می باشد و بیان می دارد که سوزن در موقعیت خطر نیست و همچنین تنظیم نیست.

رنگ سبز: اعلام میدارد که در وضعیت تنظیم سوزن قرار داریم و در کلیه مراحل آزمایش باید رنگ این چراغ سبز باشد و اگر احیاناً قرمز شود باید فاصله سوزن را از سطح بلور افزایش دهیم. پس از این مرحله، جاروب، scan را شروع کنید، برای اینکار نخست روی آیکون full در زمینه بالای پنجره بزرگ در صفحه کلیک کنید و پس از آن روی start کلیک کرده آنگاه تصاویری روی صفحه کامپیوتر رؤیت می شود که عکس سطح بلور را با توجه به مکانیسمی که توضیح داده شده است، ارسال میدارد.

در مرحله بعد، نوک سوزن را بایست به طور عمودی روی سطح بلور تنظیم کنیم این کار تو سط دو آیکون x-slop و Y-slop انجام می شود، روی صفحه دو تصویر ظاهر می شود، یک تصویر کل محدوده مربوطه را نمایش می دهد و دیگری تصویر یک خط را نمایش می دهد. با کلیک کردن روی هر دو آیکون x-slop و y-slop تا جائیکه تصویر خط به صورت کاملاً افقی درآید ادامه دارد حال سوزن بر سطح بلور عمود شده است و این مرحله نیز به پایان می رسد. در این بخش خوبست تعدادی از تصاویر ثبت شده از قبل را نمایان کرده و با تنظیم توسط نرمافزار آشنا شوید.

آزمایش 1

مشاهده تصویر اتمی سطح نمونه گرافیت و ثبت نمودار (V)

دستگاه STM را روشن کنید. مطمئن شوید نمونه در محل خوبی قرار دارد. هرگونه جابجایی نمونه حتماً توسط مسئول آزمایشگاه انجام شود. حال پس از آشنائی مقدماتی با نرمافزار فاصله سوزن با نمونه را تنظیم کنید. حین کاهش پلهای فاصله، مساحت مورد عکس بردای را مشاهده و در صورت خوب بودن مساحت را کاهش دهید. کاهش فاصله در این مرحله با آیکون z-Range انجام می شود و کاهش مساحت با-scan صورت می گیرد. مرحله به مرحله تصویر واضحتر قابل لمس تر می شود. البته بایست به این نکته توجه کرد که باید فرود سوزن به روی مکان مناسبی بگیریم که در این صورت بهتر است بر روی آیکون full کلیک کرده (یعنی سوزن را از سطح دور کنید) مجدداً در ناحیه

دیگری start کنید یا میتوان از ابتدای مراحلی که گفته شده بار دیگر شروع کرد. البته برای گرفتن تصاویر دقیق و وا ضح از آیکون zoom نیز میتوان استفاده کرد. روی آیکون zoom کلیک کرده قسمتی از تصویر را انتخاب میکنیم [چه برنامه در حال start با شد چه در حالت [stop] بعد از این عمل نرمافزار فقط تصویر آن ناحیه را میدهد. سعی کنید در جایی که فرود میآییم حتیالامکان یکنواخت باشد.

برای سـه بعدی کردن تصـویر یا اگر سـه بعدی اسـت، دوبعدی کردن تصـویر از Display اسـتفاده می کنیم روی display کلیک سـه مورد Lineview, 3D view, Top view رؤیت می شود.

Top view مربوط به دوبعدی کردن تصویر و 3D view برای سه بعدی کردن تصویر به کار می رود، با کلیک کردن روی هر کدام از آنها و کلیک روی (می دورد نصویر به کار می رود، با کلیک کردن روی هر کدام از آنها و کلیک روی (می دورد نصویر کردن (می شود، وارد فضای دوبعدی یا سه بعدی می شویم. برای بهتر کردن کیفیت تصویر از لحاظ پررنگ و کمرنگ بودن، از optimize استفاده می کنیم. در اینجا نرم افزار مساحتهای مربع شکل را انتخاب میکند و وقتی مقدار sampls را تغییر می دهیم در واقع هر دو بعد به یک مقدار تغییر می یابد. sampls بیانگر تعداد نقاط نمونه است که در آزمایش، نرم افزار برای نشان دادن شکل استفاده می کند. با افزایش مقدار sampls تعداد نقاط که در نمایش تصویر بکار می رود بیشتر می شود.

طريقه ذخيرهسازي اطلاعات

برای ذخیره کردن تصویر دلخواه ابتدا سیستم را به حالت ساکن درآورده که این کار با کلیک کردن دکمه start که در حین اجرایscan به stop تغییر فرم می دهد، انجام می شـود و دوباره فرم آن (با این کلیک) به start برمی گردد و عمل scan متوقف می شـود و در این حالت سیستم آماده ذخیره سازی تصویری است که بر روی مانیتور مشاهده می شود.

روی دکمه photo کلیک می کنیم و سپس دکمه file در زمینه فعال بالای صفحه کلیک کرده آنرا open می کنیم، به دو طریق می توانیم ذخیره سازی اطلاعات را انجام دهیم:

1- از save as استفاده می کنیم، در save as باید اطلاعات را با توجه به پسوندی که برایeasy scan تعریف شده است، ذخیرهسازی کنیم.

2- مورد دوم Export است، که از آن نیز میتوان استفاده کرد. ولی در این حالت میتوان اطلاعات را با پسوند دلخواه ذخیرهسازی کرد. در این قسمت اطلاعات را به صورت bmp وAscii ذخیرهسازی میکنیم، برای این امر آدرس زیر مورد احتیاج است:

Data set as\plotfile Ascii

لازم به یادآوری میباشد که دانشجویان بایستی یک پوشه در مکان C\easy scan\expriment به تاریخ روز به نام خودشان ایجاد کنند و بعد از آن به ذخیره اطلاعات بپردازند. بعد از ذخیره سازی تصاویر، نوبت مشاهده و ذخیره سازی اسپکترو سکوپی I بر حسب V می سد. توجه داشته با شیم spectroscopy در یک نقطه (محل مشخص از اتمها) انجام میگیرد، برای این امر روی دکمه spec کلیک میکنیم و سپس روی start کلیک میکنیم آنگاه نموداری با پنجره ای جدید همراه به آیکون های مختلف بر روی آن ظاهر می شود، که با آن دکمه ها میتوان Voltage و همچنین فاصله را کم و زیاد کرد و نمودارهای مختلف تحت این تغییرات را مشاهده و ذخیره کرد.

لازم است از یک تصویر واضح برای انجام محاسبات استفاده شود، در گام اول از روی این تصویر باید بتوانیم در مورد شبکه اتمی آن اطلاعات بدست آوریم، درگام دوم محاسبات صفحه بعد را انجام دهید.

خواستههای آزمایش

1- سعى كنيد تصاوير واضحى از سطح نمونه بدست آورده و ثبت كنيد.

2- در نقاط مشخصی از سطح، چند تصویر I-V گرفته و ثبت کنید.

فایلها را بصورت تصویر عددی برای انجام محاسبات از روی کامپیوتر کپی کنید.

آزمایش 2

محاسبه زبرى سطوح

مشاهده شده است در رشد سطوح، واریانس ضخامت نقاط سطح از ابتدای رشد شروع به افزایش و پس از مدت Δt_x به مقدار ثابتی می رسد که آنرا واریانس اشباع سطح $W_{sat}(L)$ مینامیم.

$$W(L,t) = \sqrt{\frac{1}{L} \sum_{i=1}^{L} \left[h(i,t) - \overline{h}(t) \right]^2}$$

در این فرمول h ارتفاع هر نقطه i در زمان t از سطح است و \overline{h} متوسط ارتفاع نقاط است.

سرای مدلهای با بعد محدود بستگی به اندازه نمونه، L دارد و این مقدار با نمای زبری، بدین صورت تغییر می کند.

$$W_{sat}(L) \approx L^a \quad [t\rangle\rangle t_x$$

که a یک عدد است. در آزمایشات تجربی، برای بد ست آوردن نمای ر شد یک لایه نازک بخصوص، از روش دیگری مشابه روش فوق استفاده می شود. تابع همبستگی ارتفاع به صورت زیر می باشد.

$$C(t) = \left[\langle (h(x) - h(x'))^2 \rangle x \right]^{\frac{1}{2}} \qquad \left(|x - x'| = l \right)$$

که < > میانگین گیری روی نقاط نمونه است و در این رابطه مکان انتخابی است.

بدین منظور برای هر سطح بازاء l های متفاوت $l \leq l \leq 50$ میانگین $\langle h(x) - h(x') \rangle$ را روی سطح محاسبه نموده مقدار l را روی سطح محاسبه نموده مقدار l بدین منظور برای فوا صل کوچکتر از طول همبستگی رابطه $l \leq l \leq 0$ و $l \leq l \leq 0$ برقرار است که بدین و سیله می توان محا سبه نمود. در نمونهها واریانس از یک حدی بیشتر نمی تواند باشد این مسئله گویای آن است که نقاط مختلف نمونه به یکدیگر وابسته اند. بیشترین فاصله ای که در آن نقاط مختلف نمونه به هم وابسته می شوند را طول همبستگی $l \leq l \leq 0$ می گوئیم.

قدمهای نوشتن برنامه محاسبه a

ابتدا باید از تصویر خود یک آرایه N imes N بسازید که در هر یک از اعضای آن ارتفاع نقطه مورد نظر را در خود دارد. داشتن فایل تصویر بصورت Ascii لازم است.

میانگینگیری

میانگین گیری بدین صورت انجام می شود:

$$C'(L) = \frac{\sum (h_{ij} - h_{ij+l})^2 + \sum (h_{ij} - h_{i+lj})^2}{2}$$
$$C(l) = \frac{C'(l)}{number}$$

روی آرایه فوق با تغییر مقادیر j,i از مقدار i تا i,i میتوان مجموع فوق را بدست آورد با تقسیم بر تعداد جملات، میانگین i,i را بدست آورد.

برای ثابت بودن تعداد جملات در هر میانگین گیری می توان جمع $\sum_{t=1}^{N-\eta'}$ انجام داد که η' بزرگترین قدمی است که C(l) برای آن محاسبه می شود.

مقادیر C(l) به ازاء طولهای ابتدایی آن C(l) و رسم منحنی منحنی C(l) بر حسب C(l) در رابطه نمایی به ازاء طولهای ابتدایی آن C(l) مشاهده می شود و از روی آن نمای زبری C(l) محاسبه می شود. می توان برای کوتاه شدن برنامه تنها روی یک خط میانگین گیری کرد و میانگین به صورت زیر می شود.

$$C(l) = \sum \left[\frac{(h_{ij} - h_{i,i+l})^2 + (h_{ii} - h_{i+l,i})^2}{2} \right]$$

البته فقط این روش بخاطر کمتر بودن تعداد عناصر در جمع کمتر خواهد بود.

ا در ورودی میخواهیم. 1 imes n ایک فایل به صورت ماتریس 1 imes n

.ماتریس میسازیم $[h(i)]_{1 imes n}$ ماتریس -2

$$C(l) = (\langle h(x) - h(x+1)^2 \rangle x)^{\frac{1}{2}}$$
 تعریف تابع همبستگی در یک بعد چنین است: -3

به این صورت باید برای هر l یک C(l) بدست آوریم.

4- برنامه پیشنهادی:

While *l*<120

 $h_2=0; n=0$

For l=1 to 120

$$h_L = h_2 + (y(i) - y(i+1))^* (y(i) - y(i+1));$$

n=n+1;

end;

m=m+1

I=I+1

end;

. آرایهایست که در آنها l های مربوط به هر (m) نگهداری می شود.

. در نهایت باید (C(m) را بر حسب lr(m) رسم کرد.

6- و می توان نمای a را حساب کرد.

بررسي نتايج و سؤالات

1- با مقایسه ابعاد اتمی شبکه گرافیت با تصویر بدست آمده با دقت اتمی سعی کنید فواصل اتمها و آرایش آنها را تعیین کنید.

رسم شود. و با تصویر C(l) بر حسب C(l) از نمونه محاسبه نمائید. به این منظور نمودار C(l) بر حسب C(l) بر حسب C(l) بر حسب C(l) دمای زبری سطح را با تصویر

dI/dV استفاده از فایل آن اطلاعات نمودار V را ثبت کنید (در چند نقطه تصویر) و سپس با استفاده از فایل آن اطلاعات نمودار V را بر حسب V رسم نمایید.